ITERトロイダル磁場コイルの 製作法確立と実機製作

久野和雄* 湊 恒明** 長谷川 満***

Development of ITER Toroidal Field Coil Manufacturing Process Kazuo Kuno, Tsuneaki Minato, Mitsuru Hasegawa

要 旨

国際熱核融合実験炉ITER(International Thermonuclear Experimental Reactor)は長時間の核融合反応の実証を目 指し、日本・欧州連合(EU)・ロシア・米国・韓国・中国・ インドの国際協力で製作が進められている。三菱電機は、 1970年代から核融合実験炉の事業に取り組んでおり、多 くの製作実績を活用することで、現在ITERの支援及び発 電を実証する原型炉への補完研究を目的としたJT-60SA (Super Advanced)用超電導コイルとともにITERのトロ イダル磁場コイル(以下"TFコイル"という。)の製作に参画 している⁽¹⁾⁽²⁾。

ITERのTFコイルは1コイルが幅9m, 高さ15m, 質量300トン, 巻線パック質量110トンの世界最大の核融合

用大型超電導コイルである。TFコイルの製作は三菱重工 業㈱(MHI)と共同受注し,MHI二見工場内で協力して製 作を進めている。三菱電機は巻線部分を担当している。

超電導線は高磁場の発生が可能なNb₃Sn(ニオブ3スズ) であり、巻線後にNb₃Sn生成のための熱処理が必要であ る。また、電磁力が強大で、電磁力支持のため導体をラ ディアルプレートと呼ばれる構造物に組み込む必要がある。 これらの点及び超大型コイルであることによって製作が難 しく、製作法確立のために各種の試作を行い、技術課題を 解決するとともに製作設備の準備を進め、実機量産を開始 する段階となっている。



国際熱核融合実験炉ITERとTFコイル巻線

ITERは直径約30m, 質量23,000トンの大型炉である。核融合反応させるプラズマを強力な磁場で閉じ込めるため、大型の超電導コイルが 使われる。プラズマ閉じ込めを担うTFコイルは日本とEUで分担して製作される。TFコイルの1コイルのサイズは9×15(m)である。

1. まえがき

三菱電機は2012年ITERのTFコイルの製作をMHIと共 同受注した。巻線部を三菱電機が担当し、ラディアルプ レートなどの構造物をMHIが担当している。TFコイルは 大型で重いため(巻線パック質量110トン),製作の効率化, 製作中の輸送を少なくする等の観点から,MHI二見工場 の大型機器工場内で巻線の製作を行っている。2社が同一 工場で製作に取り組むことによって、得意分野をそれぞれ が担当して協力する体制ができている。また、巻線製作の ための各種設備の製作が終わり、実機製作が軌道に乗り出 した。

本稿では、ITERのTFコイルの製作法と試作・実機製 作の状況について述べる。

2. TFコイル巻線

TFコイルはコイルケースと巻線パック(WP)からなる (図1)。図2は巻線の断面である。導体はNb₃Sn超電導素





図2. 巻線の断面

線をより線にし,直径43.7mmのSUSジャケットで囲われ ている。導体は絶縁されて,ラディアルプレート(RP)と 呼ばれるステンレスの補強板に収められる。WPは7個の ダブルパンケーキ(DP)を積層して,全体を絶縁し,樹脂 で固めて製作される。WPの製作手順を図3に示す。

TFコイル製作の特徴を次に挙げる。

- (1) 実績のない超大型コイルであり,各プロセスに技術課 題がある。多くの試作開発を実施して,課題を解決し ている。
- (2) 製作方法の検討とともに設備を計画し,準備する必要 がある。全ての製作設備を新たに製作した。
- (3) 不具合による後戻りは致命的となる。十分な検討と品 質管理を行う。

3. 巻 線

巻線,熱処理後にRPの狭い溝に収納するため,大径 (直径43.7mm)の導体であるにも関わらず,高精度の巻線 が必要である。特にRPの溝周長と合わせるため,周長を 0.01%程度で管理する必要がある。高精度巻線のため,次 のような開発又は対策を実施している。

- (1) 導体曲げシミュレーションコード開発
- (2) 高精度の巻線対応の巻線ヘッド開発
- (3) 導体測長システム開発
- (4) 巻線室の温度管理
- (5) 回転テーブル上の導体受け台を高精度にアラインメン トし,これに導体を収納して精度を保証
- (6) 熱処理によって超電導線が約0.07%(1ターン当たり 23mm)伸びる現象がある(図4)。試作及び実機製作 結果を巻線寸法へ反映して製作

これらを実施することで、問題なくRPへの巻線挿入が できている。巻線の周長誤差は要求仕様0.01%に対し、実績



図3. WPの製作手順

特集論文





図5. 巻線装置

平均0.0012%である。開発された測長システム,巻線ヘッド 等で構成された巻線装置を図5に示す。装置は全体が同期 して制御され,シミュレーション結果で自動に巻かれる。

4. トランスファ

巻線及び熱処理されたDPの層間にRPを挿入し, RPの 溝内に導体を挿入する。1本の導体で巻線されたDPであ るため,層間の渡り部を横切ってRPを挿入できず,RPを 複雑に操作して,挿入を行う。熱処理後の導体であるため, 導体に発生する歪(ひずみ)を0.1%以下に管理して,作業 する。このための装置が図6,図7に示すトランスファ装 置である。挿入の動作はトランスファ試験の結果を反映し てプログラムされており,安全に作業することができる。 RP挿入後,導体をRP溝内に収納し,反転した後,残った 側の導体を挿入する。

5. 導体絶縁

RPの溝内に挿入された導体を一旦持ち上げ,導体絶縁 してクエンチ検出テープを巻いた後,再度溝に収納するた めの装置が導体絶縁装置である。ほかの装置同様,独自開 発したものであり,D型のDPに沿って,テーピングマシ ン,導体昇降装置等が周回して,絶縁を施す(図8,図9)。



図6. トランスファ装置



画像提供:国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構

図7. トランスファ(RP挿入)作業



図8. 導体絶縁装置



画像提供:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

図9. 導体絶縁作業

6. DP含浸

CP溶接及びDP絶縁されたDPにレジンを注入し,加熱 硬化を行う。耐放射線性の高いシアネートエステル樹脂と エポキシ樹脂を混合して,使用することになっている。ま



画像提供:国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構

図10. DP含浸装置全景(含浸容器を傾斜させた状態)



画像提供:国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構



た,冷却による樹脂の割れを防ぐため,樹脂リッチにならな いように(ガラス繊維の割合を高く),絶縁を施工する。含浸 工程は各種の試作を行い,そのプロセスと条件を決めている。

図10は樹脂を含浸容器内に注入する際の写真であり、 樹脂内にボイドが発生することを避けるため、含浸容器を 傾斜させ、下から樹脂を注入している。実機製作前に2種 類のダミーDPを製作し、含浸を含めた製作プロセスの最 終確認を実施している。図11は含浸・加熱硬化後のDPの 外観、図12はダミーDPを含浸して切断したものの含浸状 況を示す。導体絶縁内部まで、一様に含浸できていること が確認された。

DP含浸工程は含浸準備及び含浸後の手入れ等に時間が かかるため、2台の含浸容器を用意してDP製作ピッチを 守るよう計画している。

7. WP製作

含浸されたDPは7個積層され、対地絶縁後、再度含浸 を行って、WPとなる。

図13はWP含浸のための容器を示したものである。DP 積層後に,WP周囲に容器壁を組み立て,溶接して含浸容 器を構成する構造としている。周囲をクランプで加圧した 状態で全体を3°傾斜させ,含浸を行う。

含浸後,最終的なWPの試験として,液体窒素による 冷却試験を行う。冷却履歴を与えた後,真空リークテス



画像提供:国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構

図12. 含浸状況(ダミーDPを含浸して切断したもの)



図13. WP含浸のための容器

トと電気試験を実施し、WPの健全性を確認するためであ る。この試験の試行として、ダミーDPを用いた試験を行い、 ほぼ計画どおり冷却でき、また真空リークテスト、電気試 験とも問題なくパスしている。

8. む す び

ITERのTFコイルの製作は発注元の量子科学技術研究 開発機構による指導の下,ITER機構,EU国内機関(F4 E)等とも技術交流を行って製作を進めている。

現在までに、DP製作に関する試作は終わり、実機製作 もDP含浸まで進んでいる。DP製作に関しては、軌道に乗 り出した段階である。

WP製作及びコイルケースとの一体化はこれから取り組 む作業である。若干の技術課題が残っているが、これらに ついて早急に解決を図り、十分な品質管理を行って製作を 成し遂げたい。

TFコイルの製作によって得られる技術を,将来の原型 炉の設計・製作にも活用できるように取り組む。

参考文献

- 野元一宏, ほか:核融合用大型超電導コイルの製作, 三菱電機技報, 87, No.11, 652~655 (2013)
- (2) Hasegawa M.,et al. : Manufacturing of JT-60SA equilibrium field coils, Proceedings of ICEC 24-ICMC 2012, 571~574 (2012)